### 緑波長域における可飽和吸収体としてのトポロジカル絶縁体ナノシートの作製

Fabrication of Topological Insulator Nanosheets as a candidate for saturable absorber of green lasers

飯島 功大(M1)

Kodai Iijima

#### Abstract

Recently, so-called topological insulator nanosheet materials such as transition metal dichalcogenides (TMDs) have being attracted much attentions. We consider those TMD nanosheets as promising materials which can act as a saturable absorber even for green laser light, and attempt to fabricate WS<sub>2</sub> nanosheets by a liquid-phase exfoliation method.

#### 1. はじめに

可視域に発光遷移を有する希少なレーザ媒質の一 つとしてプラセオジムイオン(Pr<sup>3+</sup>)がある. Pr<sup>3+</sup>は 可視域に青~深赤色にわたる広帯域において発光 遷移を持ち,波長変換技術を介さなくては一般的に は得られない可視光レーザ発振を高効率に得られ るレーザ媒質として注目されている. これまで Pr3+ を YLF へとドープした Pr<sup>3+</sup>: YLF をレーザ媒質と して用いた可視固体レーザの研究が高出力化や各 種パルス動作などの研究が行われてきた.とくに, パルス動作については、Cr4+:YAG を可飽和吸収体 (Saturable Absorber; SA)として用いた受動 Q スイ ッチ動作を赤、オレンジ波長域において世界に先駆 けて実現している[1]. しかし,一方で緑波長での受 動 Q スイッチ動作はこれまで未達成である.これ は、緑波長における Pr<sup>3+</sup>: YLF の利得が小さい為 に SA の吸収を飽和させるだけの光強度を得る事 が難しいことと、緑波長での SA の飽和強度が非常 に高いためである.

そこで我々は近年、広い波長域においてすでに SA

として動作する事が報告され[2],注目を集めてい る遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)系ナノシー トを緑波長域における有望な可飽和吸収体候補で あると考え,これを用いた緑波長での Pr<sup>3+</sup>:YLF レ ーザの受動 Q スイッチ動作実現を目指す研究に着 手した.ここでは,液相剥離法による TMD 系ナノ シート作製に関する報告をする.

## 2. ナノシート作製について

ここでは、液相剥離法による TMD 系ナノシートの 作製原理と具体的な手順について述べる. そもそも TMD はグラフェンのような層状の分子構造が積層 したような構造を有しており、これを少数もしくは 単層化することで電子数を光励起で枯渇できる程 度にまで制限し、可飽和吸収現象が実現できる. 今 回, 緑波長での可飽和吸収体として作製を目指した のは,これまでに赤波長域での可飽和吸収体として の動作がすでに報告されている[3]二硫化タングス テン(WS2)のナノシート及び深赤、赤、オレンジ波 長域で受動 Q スイッチ動作の実現がすでに報告さ れている[4]二硫化モリブテン(MoS<sub>2</sub>)である. 手順 概要を Fig. 1 に示す. 当該ナノシート作製は適正 溶媒中で試料である遷移金属層状分子を単数~少 数層化し,均一に拡散した溶液を作製することに始 まる. WS<sub>2</sub>の場合は、まず WS<sub>2</sub> 粉末 (Alfa Asaer 社製)を NMP 溶液に加え, スターラーで数十分間 にかけて撹拌して溶解させる事で<1 at.%程度の 溶液とする. その後, 少数層化を図るため, 超音波



Fig. 1. The schematic diagram of TMD nanosheets fabrication.

	溶媒(NMP)	溶質(WS2)	撹拌時間	超音波処理時間	スピンコート	ベイク
試料 A	30ml	0.918g	20 min	30 min (24kHz)	2000rpm 10min	90°C 120min
試料 B	30ml	0.918g	20 min	60 min (24kHz)	2000rpm 10min	90°C 90min

Table 1. Parameters of WS<sub>2</sub> nanoheets fabrication.

洗浄機により超音波処理を施す. こうして作製され たナノシート溶液を BK7 ガラス基板(シグマ光機 製 Φ1cm)上に 2000 rpm で 10 分間かけてスピンコ ートする.スピンコート工程後には 80~90 ℃の定 温乾燥機内でベイクし,最後に常温で静止すること で室温にまで自然冷却する.ここでは比較の為に作 製パラメータの異なる 2 種類の試料作製について 言及する.また, MoS2に関しても同様の手順によ って作製が可能である.

#### 3. 作製の評価計測について

作製したナノシート試料 A について, ラマン分光 による各目標分子の存在確認, SEM 画像による表 面状態の確認, DFM による膜厚計測などの計測を 行った. Fig. 2 にラマン分光計測結果を示す. この 結果は WS<sub>2</sub>の持つラマンシフト 350.5 cm<sup>-1</sup>および 420.7 cm<sup>-1</sup>と完全に一致する結果となっており, 基 板上の目的金属の存在を確認する事ができた. Fig. 3 に取得した試料表面の SEM 画像を示す. この Fig. 3(a)から点在する WS<sub>2</sub> が確認され, (b)からは各 WS<sub>2</sub> 分子が積層してしまっている様な状態を確認 する事ができる. この状態は Fig. 1 の超音波処理 日よる少数層化の概要図における分子層間の剥離 が不十分の時の状態に酷似しており,現状の超音波 処理時間ではまだ全ての WS2 分子を均一に単数・ 少数層化するには不十分であるということが分か る. この SEM 画像データを踏まえ, DFM による 膜厚計測 (Fig. 4) を行った. WS2の単層分子の膜 厚が 0.8 nm[5]である事を考慮すると, 膜厚状態の データからは,未だに数十層におよぶ分子層構造を 保持している分子の存在が示唆される結果になっ ており, SEM 画像データから示唆された超音波処 理時間不足による少数層化の不完全さを再認識さ せられる結果となった.



Fig. 2. Raman shift of WS<sub>2</sub> nanosheet.



Fig. 3. SEM images of  $WS_2$  nanosheet. (a)×1000 100  $\mu m$  square (b)×10000 10  $\mu m$  square



Fig. 4. DFM measuring result of  $WS_2$  nanosheet (sample A).

# 4. ナノシート作製パラメータに関して

ここでは、TMD 系ナノシート作製に関する作製パ ラメータに関して最も重要になる単数・少数層化 (作製膜厚)と超音波処理時間の関係について考察 する. Table 1 の試料 A の比較対象として超音波処 理を長く施した試料 B についての DFM 計測結果 を Fig. 5 に示す. Fig. 5 から分かる各分子厚である が、Fig. 4 の結果に対して全体的に小さい値になっ ているという兆候がみられる. このことから、超音 波処理時間に反比例する関係で膜厚は小さくなっ ていくのだという結論が得られ,更に長時間の超音 波処理を施せば可飽和吸収体として機能する試料を 作製出来る可能性が高い.しかし,一方であまり長 時間の超音波処理を施してしまうと分子層の狭面 積化を助長してしまうという研究報告もあるので, 試料は面積と層数(膜厚)の関係からその超音波処 理時間を最適化する事が求められる.



Fig. 5. DFM measuring result of WS<sub>2</sub> nanosheet (sample B).

# 5. まとめ

近年,広帯域にかけて可飽和吸収体として動作する ことが明らかになり,注目を集めている遷移金属大 ガルゴゲナイドナノシート作製を行った.層状分子 の積層した構造をどれだけ適切に剥離することが できるかという点が重要になるが,処理時間に反比 例して層数が減少する兆候を確認する事ができた. しかし,まだ実験で試みた程度の処理時間では少数 層化が不十分であると考えられる為,処理時間の増 大に起因する分子層の狭面積化を考慮しつつ,その 最適化をする事が今後必要となる.

#### References

- Abe, R., Kojou, J., Masuda, K., & Kannari, F.,
  "Cr4+-doped Y3Al5O12 as a saturable absorber for a Q-switched and mode-locked 639-nm
   Pr3+-doped LiYF4 laser." *Applied Physics Express*, 6(3), 032703 (2013).
- Sh. Wang, H. Yu, H. Zhang, A. Wang, M. Zhao,
  Y. Chen, L. Mei, and J. Wang, "Broadband Few-Layer MoS2 Saturable Absorbers", Adv. Mater.
   26, 3538 (2014).
- [3] Cheng, Y., Yang, H., Xu, B., Xu, H., Cai, Z., & Moncorge, R., "Passive Q-switching of A Diodepumped Pr: liyf 4 Visible Laser Using WS 2 As Saturable Absorber." In *Advanced Solid State Lasers* (pp. ATh2A-10). Optical Society of America (2015).
- [4] Zhang, Y., Wang, S., Yu, H., Zhang, H., Chen, Y., Mei, L., & Wang, J. "Atomic-layer molybdenum sulfide optical modulator for visible coherent light." *Scientific reports*, *5* (2015).
- [5] Yun, W. S., Han, S. W., Hong, S. C., Kim, I. G., & Lee, J. D., "Thickness and strain effects on electronic structures of transition metal dichalcogenides: 2H-M X 2 semiconductors (M= Mo, W; X= S, Se, Te)." *Physical Review B*, *85*(3), 033305 (2012).